

附件

512 Mb FCRAM-MB81EDS516545 的主要规格

存储器架构	2M word × 64 bit × 4 banks	
电压	1.7 V ~ 1.9 V	
接口	低功耗 DDR SDRAM (CMOS)	
工作温度范围 (结温)	-10 °C ~ +125 °C	
突发工作频率	最高: 105 °C	216 MHz (最高)
	最高: 125 °C	200 MHz (最高)
数据传输率	最高: 105 °C	3.46 GB/秒 (最高)
	最高: 125 °C	3.2 GB/秒 (最高)

256 Mb FCRAM-MB81EDS256545 的主要规格

存储器架构	1M word × 64 bit × 4 banks	
电压	1.7 V ~ 1.95 V	
接口	低功耗 DDR SDRAM (CMOS)	
工作温度范围 (结温)	-10 °C ~ +125 °C	
突发工作频率	最高: 105 °C	216 MHz (最高)
	最高: 125 °C	200 MHz (最高)
数据传输率	最高: 105 °C	3.46 GB/秒 (最高)
	最高: 125 °C	3.2 GB/秒 (最高)